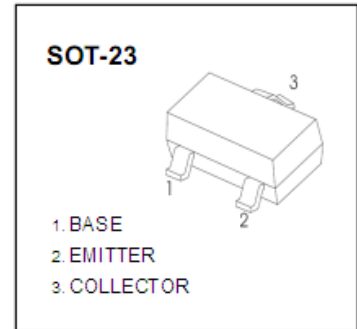


**SS8050 (NPN)****印章/Marking : Y1****特点/Features :**I_c 电流大 ;**用途/Applications :**

用于功率放大电路 , 与 SS8550 互补。

**极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)**

| 参数/Parameter | 符号/ Symbol | 数值/Value | 单位/Unit |
|--------------------------------------|------------------|-----------|---------|
| 集电极-基极电压/Collector-Base Voltage | V _{CB0} | 40 | V |
| 集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage | V _{CE0} | 25 | V |
| 发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage | V _{EB0} | 5 | V |
| 集电极连续电流/Collector Current Continuous | I _c | 1.25~1.5* | A |
| 集电极耗散功率/Collector Power Dissipation | P _c | 0.3 | W |
| 结温/Junction Temperature | T _j | 150 | °C |
| 储存温度/Storage Temperature | T _{stg} | -55~150 | °C |

注 : I_b 在 100mA 时 , I_c 可在 1.5A 连续工作 , I_b 减小时 , I_c 最大连续工作电流会减小。**电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)**

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-------------|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 集电极-基极击穿电压 | V _{BR(CB0)} | I _c =100 μA, I _E =0 | 40 | | | V |
| 集电极-发射极击穿电压 | V _{BR(CE0)} | I _c =100 μA, I _B =0 | 25 | | | V |
| 发射极-基极击穿电压 | V _{BR(EB0)} | I _E =100 μA, I _C =0 | 5 | | | V |
| 集电极截止电流 | I _{CB0} | V _{CB} =40V, I _E =0 | | | 0.1 | μA |
| 发射极截止电流 | I _{EB0} | V _{EB} =5V, I _C =0 | | | 0.1 | μA |
| 集电极发射极穿透电流 | I _{CE0} | V _{CE} =20V, I _B =0 | | | 0.1 | μA |
| 直流电流增益 | h _{FE(1)} | V _{CE} =1V, I _C =100mA | 120 | | 400 | |
| 直流电流增益 | h _{FE(2)} | V _{CE} =1V, I _C =800mA | 40 | | | |
| 集电极-发射极饱和压降 | V _{CE(sat)} | I _C =800mA, I _B =80mA | | | 0.5 | V |
| 基极-发射极饱和压降 | V _{BE(sat)} | I _C =800mA, I _B =80mA | | | 1.2 | V |
| 特征频率 | f _T | V _{CE} =10V, I _C =50mA, f=30MHz | 100 | | | MHz |

h_{FE} 分档/Classification of h_{FE} (1)

| 档位/Rank | L | H | J |
|----------|---------|---------|---------|
| 范围/Range | 120~200 | 200~350 | 300~400 |



典型特性曲线图/Typical Characteristics

